

3. 6. 3. 1 (4) リソグラフィ装置 (貨物等省令第6条第十七号へ、ヲ、エ、テ)

(1) 政省令等の抜粋

輸出令別表第1	
7の項	(16) 半導体素子、集積回路若しくは半導体物質の製造用の装置若しくは試験装置又はこれらの部分品若しくは附属品

貨物等省令	
第6条第十七号	半導体素子、集積回路若しくは半導体物質の製造用の装置 (ホ及びレにおいて「半導体製造装置」という。) 若しくは試験装置であつて、次のいずれかに該当するもの又はこれらの部分品若しくは附属品
へ	<p>リソグラフィ装置であつて、次のいずれかに該当するもの</p> <p>(一) ウエハの処理のためのステップアンドリピート方式又はステップアンドスキャン方式の露光装置であつて、光学方式のもの又はエックス線を用いたもののうち、次のいずれかに該当するもの</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 光源の波長が193ナノメートル未満のもの</li> <li>2 ナノメートルで表した光源の波長に0.35を乗じて得た数値を開口数の値で除して得た数値が45以下のもの</li> </ol> <p>(二) <u>インプリントリソグラフィ装置</u>であつて、45ナノメートル以下の線幅を実現することができるもの (テに該当するものを除く。)</p> <p>(三) マスクの製造をすることができるように設計した装置であつて、電子ビーム、イオンビーム又はレーザー光を用いたもののうち、次のいずれかに該当するもの</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 照射面の半値全幅の直径が65ナノメートル未満、かつ、イメージ位置誤差 (平均値に3シグマを加えたもの) が17ナノメートル未満のもの</li> <li>2 削除</li> <li>3 マスク上の2層目の重ね合わせ誤差 (平均値に3シグマを加えたもの) が23ナノメートル未満のもの</li> </ol> <p>(四) 直接描画方式で半導体素子又は集積回路の製造をすることができるように設計した装置であつて、電子ビームを用いたもののうち、次のいずれかに該当するもの</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 照射面の直径が15ナノメートル以下のもの</li> <li>2 重ね合わせ誤差 (平均値に3シグマを加えたもの) が27ナノメートル以下のもの</li> </ol>
ヲ	<p>ウエハの処理のためのステップアンドリピート方式又はステップアンドスキャン方式の露光装置であつて、光学方式のものであり、かつ、光源の波長が193ナノメートル以上のもののうち、次の (一) 及び (二) に該当するもの (へ (一) 2 に該当するものを除く。)</p> <p>(一) ナノメートルで表した光源の波長に0.25を乗じて得た数値を開口数の値で除して得た数値が45以下のもの</p> <p>(二) <u>同一装置による重ね合わせ精度の最大値が2.4ナノメートル以下のもの</u></p>
エ	<p>深紫外液浸フォトリソグラフィ装置において、又は、深紫外液浸フォトリソグラフィ装置とともに、次のいずれかを実施するように設計又は改造した装置</p> <p>(一) 次の全てに該当するもの</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 深紫外液浸フォトリソグラフィ装置のナノメートルで表した光源の波長に0.25を乗じて得た数値を開口数の値で除して得た数値を45以下に減少させるもの</li> <li>2 深紫外液浸フォトリソグラフィ装置の重ね合わせ精度を2.4ナノメートル以下にするもの</li> </ol> <p>(二) <u>へ(一)2又はヲに該当する露光装置</u>の任意の時間間隔における1時間当たりのウエハを処理する枚数を平均で1パーセント以上増加させるように設計又は改造したもの</p>
テ	インプリントリソグラフィ装置であつて、4.0ナノメートル以下の重ね合わせ精度を有するもの